

ダイレクト Cuピラーめっき

ダイレクトパターン方式にて、シード付き基板
へレジスト工程レスでピラーを形成しました。
成膜速度: $2 \mu\text{m}/\text{min}$

サンプル

使用装置: スタンプ式真空めっき装置

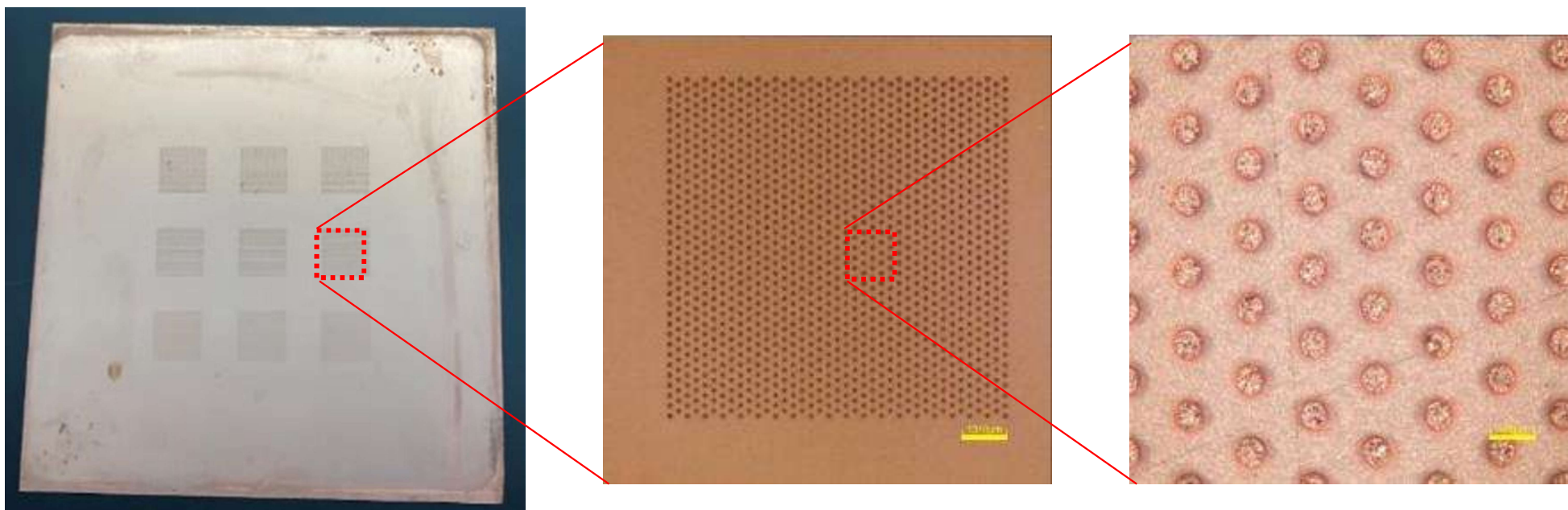
基板材質: FR4 Cu箔 $70 \mu\text{m}$

基板サイズ: $100 \times 100\text{mm}$ $t=0.3\text{mm}$

成膜エリア: Cuピラー部 ($\phi 100 \mu\text{m} \times 1307\text{個} \times 9\text{箇所}$)

浴種: 硫酸銅 (添加剤無し)

電流密度: $9.00\text{A}/\text{dm}^2$



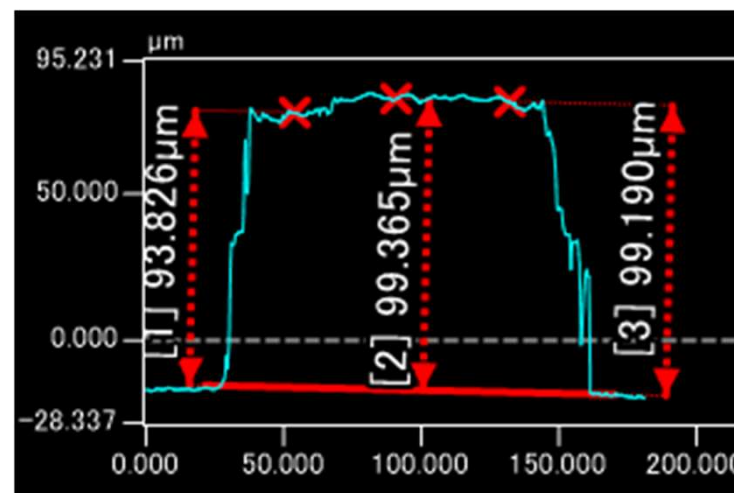
◆ピラー部詳細

径：Φ100 μm(トップ)

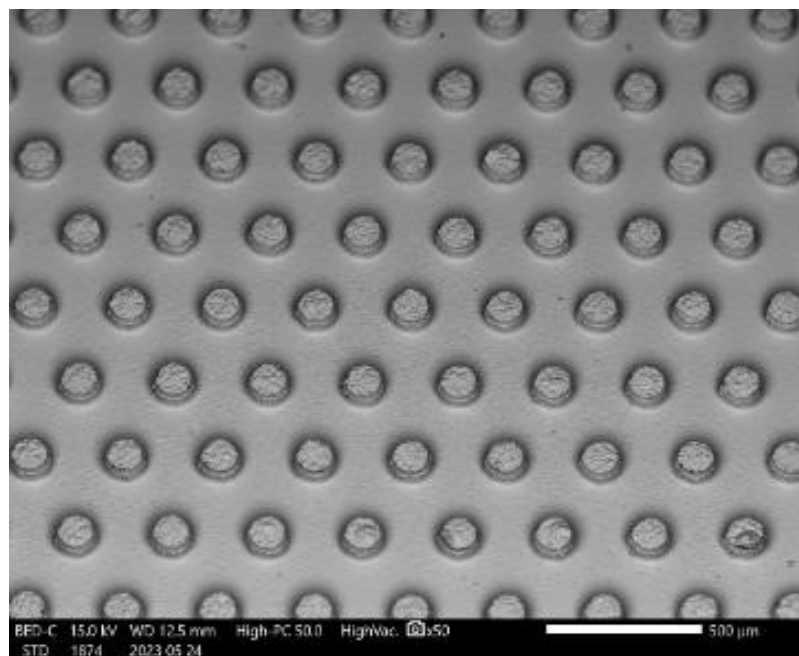
ピッチ：300 μm

高さ：100 μmねらい

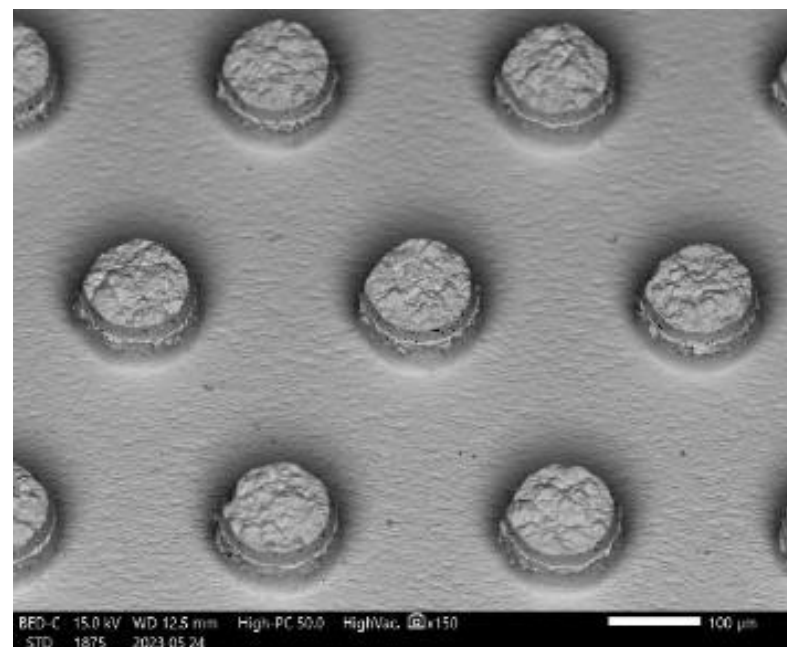
本数：1307本/cm² × 9箇所



高さ測定



× 50



× 150

